(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年1 月29 日 (29.01.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/009669 A1

(51) 国際特許分類7: C08G 61/12, C07D 333/18, 333/20

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/008900

(22) 国際出願日:

2003 年7 月14 日 (14.07.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-210221 2002年7

2002年7月18日 (18.07.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東洋合成工業株式会社 (TOYO GOSEI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒 272-0012 千葉県 市川市上妙典 1603 Chiba (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小原智

(OBARA,Satoru) [JP/JP]; 〒270-1609 千葉県 印旛郡印旛村若萩 4 丁目 2-1 東洋合成工業株式会社 感光材研究所内 Chiba (JP). 多田 健太郎 (TADA,Kentaro) [JP/JP]; 〒270-1609 千葉県 印旛郡印旛村若萩 4 丁目 2-1 東洋合成工業株式会社 感光材研究所内 Chiba (JP).

(74) 代理人: 栗原 浩之 (KURIHARA,Hiroyuki); 〒150-0012 東京都 渋谷区 広尾1-3-15 岩崎ビル7F 栗原国 際特許事務所 Tokyo (JP).

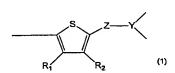
(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

/続葉有/

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING DENDRIMER, BUILDING BLOCK COMPOUND, AND PROCESS FOR PRODUCING THIOPHENE COMPOUND

(54) 発明の名称: デンドリマーの製造方法及びビルディングブロック化合物並びにチオフェン系化合物の製造方法



$$\begin{array}{c|c} H & S & Z - Y_1 - W \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$$

$$\begin{array}{c|c} H & S & Z & V_2 \\ \hline & & & V_2 \\ \hline & & & & \\ R_1 & & R_2 & & \\ \end{array}$$
 (c)

(57) Abstract: A process for producing by the convergent method a dendrimer having repeating structural units represented by the following general formula (1) which each comprises a linear moiety comprising a thienylene structure and a branched moiety (Y) comprising an optionally substituted trivalent organic group. The process comprises: a reaction step (1) in which the α -position hydrogen of the thiophene ring of a compound (a) shown below having a thienylene structure constituting an end part is converted to an active group V₁ which undergoes the Suzuki cross-coupling reaction to thereby form a compound (b) shown below; a reaction step (2) in which a compound (c) shown below comprising a linear moiety and the branched moiety (Y) and having in the branched moiety (Y) two active groups (V2) which undergo the Suzuki cross-coupling reaction with the active group (V1) is subjected to the Suzuki cross-coupling reaction with the compound (b) to obtain a compound (d) shown below; a reaction step (3) in which the α -position hydrogen of the thiophene ring of this reaction product is converted to an active group (V1) undergoing the Suzuki cross-coupling reaction and this active group (V₁) is reacted with a compound (c) shown below to form a next-generation dendrone; and a step in which the reaction step (3) is repeated according to need to form a dendrimer.

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

チエニレン構造を含む線状部と置換基を有してもよい3価の有機基である分岐部Yとからなる下記一般式(1)の繰り返し構造単位を有するデンドリマーをConvergent法により製造するデンドリマーの製造方法であって、末端部分を構成するチエニレン構造を有する下記化合物(a)のチオフェン環の α 位水素をsuzukiクロスカップリング反応する活性基 V_1 に変換して下記化合物(b)とする反応工程1と、線状部及び分岐部Yを有すると共に分岐部Yに前記活性基 V_1 とsuzukiクロスカップリング反応する2つの活性基 V_2 を有する下記化合物(c)と前記化合物(b)とをsuzukiクロスカップリング反応させて下記化合物(d)を得る反応工程2と、この生成物のチオフェン環の α 位水素をsuzukiクロスカップリング反応する活性基 V_1 に変換すると共にこれに下記化合物(c)を反応させて次世代のデンドロンを得る反応工程3と、この反応工程3を必要に応じて繰り返してデンドリマーとする工程とを具備する。

$$\begin{array}{c|c}
S & Z & Y \\
\hline
R_1 & R_2 & (1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
H & S & Z & Y_1 & W \\
\hline
R_1 & R_2 & (a)
\end{array}$$

$$V_1 & S & Z & Y_1 & W \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
V_1 & M & M & M \\
\end{array}$$

(b)



明細書

デンドリマーの製造方法及びビルディングブロック化合物並びにチオフェン系化 合物の製造方法

5

10

15

20

25

技術分野

本発明は、化学分野、医薬分野、電子材料分野などにおいて、種々の高機能材料の創製に有用な高分子材料として期待される、チエニレン構造を有する新規なデンドリマーの製造方法およびそのビルディングブロックとなる化合物並びにチオフェン系化合物の製造方法に関するものである。

背景技術

デンドリック高分子は、その高度に枝分かれした構造のため、従来の鎖状高分子とは異なる物理的、化学的性質および機能が期待されている。デンドリック高分子は大きく分けてデンドリマーとハイパーブランチポリマーに分けることができる。デンドリマーは規則的に制御された分岐構造を有するもので、一般的には中心構造となる核(コア)または開始点から、放射状かつ規則的に枝分かれした構造を有し、その分子量はほぼ単一であることから、種々の分子量の混合物である従来の高分子とは大きく異なる。低粘度性、高溶解性、非晶性などの特徴的な性質を持っており、その応用が注目されている。また、外殻部となる末端基や中心部となる核に様々な機能基を導入することで、新規な機能を発現させるといった研究が盛んに行なわれている。一方、ハイパーブランチポリマーは構造の規則性がデンドリマーほど精密ではなく、分子量や分岐度の異なる化合物の混合物である。

デンドリック高分子の合成法には、開始点あるいは核から順次枝を伸ばしていく「Divergent法」、末端から分岐ユニットをつなぎ合せて最後に開始点あるいは核に結合させる「Convergent法」、さらにAB₂型の多官能モノマーの自己縮合(ここでAとBは互いに反応する官能基を示す)などの方法が知られている。AB₂型の多官能モノマーの自己縮合は、分子量分布を持ったハイパープランチ

10

15

20

25

ポリマーの合成に利用される。「Divergent法」および「Convergent法」は、主にほぼ単一の分子量を持つデンドリマーの合成に利用される。「Divergent法」では反応点が常に最外殻にあり世代が進行すればするほど反応点の数が増加するために、欠陥が残りやすく、またそれを防ぐために過剰の反応試薬を必要とするなどの欠点がある。一方、「Convergent法」は過剰の原料を必要とせず合成中間体の精製も比較的容易である利点を有し、欠陥がなく高純度のデンドリマーを効率的に合成するには非常に有効な手段となっている(J. M. J. FrechetらChem. Rev. 101, 3819-3867(2001)参照)。

上記した「Convergent法」により合成されるデンドリマーの繰り返し構造は、主にポリアリールエーテル、ポリアリールアルキレン、ポリアリーレン、ポリアリーレン、ポリアリールン、ポリアリーレン、ポリアリールアルケン、ポリアミド、ポリカーボナートなどがある。より具体的にはポリベンジルエーテル、ポリフェニレン、ポリフェニレンビニレン、ポリフェニルアセチレン等が知られている。デンドリマーは中心構造となる核、外殻となる末端基、内部の骨格形成する繰り返し構造の組合せにより、多様な機能の発現が期待できる。従って、デンドリマーの繰り返し構造は、機能材料としての特徴に大きな影響を与えるため、より多くの構造およびその効率的な合成法が強く望まれている。

一方、チエニレン構造は、優れた電気的特性を有すること、熱や光に対して安定であることなどから、導電性π共役系ポリマーまたはオリゴマーの基本構造として研究されている。デンドリック高分子の分野でも、その中心構造である核にオリゴチオフェン構造を、または外殻となる末端基にチエニル基が導入されたデンドリマーが報告されている(J. M. J. FrechetらJ. Am. Chem. Soc., 120, 10 990-10991(1998)及びJ. Org. Chem., 63, 5675-5679 (1998)参照)。

チエニレン構造を繰り返し構造単位に含むデンドリマーおよび合成法としては、チエニレン骨格のみで構成される繰り返し構造単位のデンドリマーが開示されている (Chuanjin Xlab; Organic Letters 2002, Vol. 4, No. 12, 2067-2070 参照)。

この合成法はGrignard反応又はStilleカップリング反応でデンドリマーの世代を成長させるConvergent法である。しかしながら、Grignard反応を利用した場合



、Grignard反応は急激な発熱反応で進行するため、工業生産時の温度管理が難しく、さらに収率よく合成するためには厳密な水分管理も必要であり、大規模な製造には適さない。また、Stilleカップリング反応を利用した場合は、毒性が高い有機スズ化合物を使用する必要があり、収率よく合成するためには厳密な脱酸素工程が必要である。この方法も大規模製造には好適でない。また、繰り返し単位の分岐部分となるビルディングブロックは2,3ージブロモチオフェンのみであり、そのデンドリック構造が限定される。以上述べた以外には、チエニレン骨格の繰り返し構造単位が含まれるデンドリマー及びその合成法は知られていない。

一方、特許第3074277号公報にはチエニレンーフェニレン構造を繰り返 し構造単位とするハイパーブランチポリマーが開示されている。

しかし、この製造方法はGrignard反応による重合反応を利用しているため、デンドリマーのような規則性の高い繰り返し構造を制御することは不可能である。 したがって、この製造方法で合成した化合物は、一般的な高分子重合体と同様に 広い分子量分布を有し、中心構造となる核や外殻となる末端基へ機能基を導入し ようとしても、ランダムに導入されるため、所望の機能を得ることは難しい。

発明の開示

10

15

20

25

本発明はこの様な事情に鑑み、「Convergent法」によりチエニレン構造を有する新規なデンドリマーをより高効率かつ欠陥の少ない状態で比較的簡便に合成できるデンドリマーの製造方法及びそのビルディングブロックとなる化合物並びにチオフェン系化合物の製造方法を提供することを課題とする。

本発明者らは、デンドリマーの合成反応において、チオフェン環のα位水素を活性基に置換し、その活性基をSuzukiクロスカップリング反応させて連結する反応工程を繰り返し利用することで、高効率かつ欠陥の少ない「Convergent法」によりチエニレン構造を有する新規なデンドリマーが合成できることを知見し、本発明を完成するに至った。Suzukiクロスカップリング反応を利用することにより、Grignard反応やStilleカップリング反応の問題が解決された。さらに、このような構成をとることにより、2つ以上の反応性基と1つのマスクされた反応性基を有するビルディングブロックを用意し、デンドリマーの末端部分となる基をこ

10

15

20

のビルディングブロックに反応させた後マスクされた反応性基を脱保護し更にビルディングブロックと反応させていた従来の「Convergent法」とは異なり、マスクの工程がなく、反応工程が単純であるという優れた製造方法である。また、Suzukiクロスカップリング反応において、活性基としてホウ素が置換したチオフェン系有機ホウ素化合物を、反応相手となるハロゲン等が置換した反応性化合物を含む反応系に、徐々に連続的又は断続的に添加することで、チオフェン系有機ホウ素化合物の分解を抑制し、収率が向上することを知見し、本発明を完成するに至った。この添加方法を上記に述べた「Convergent法」によるデンドリマーの製造方法に組み合わせることで、デンドリマーの合成収率をさらに高めることが可能になった。

かかる本発明の第1の態様は、チエニレン構造を含む線状部と置換基を有してもよい3価の有機基である分岐部Yとからなる下記一般式(1)の繰り返し構造単位を有するデンドリマーをConvergent法により製造するデンドリマーの製造方法であって、末端部分を構成するチエニレン構造を有する下記化合物(a)のチオフェン環の α 位水素をsuzukiクロスカップリング反応する活性基 V_1 に変換して下記化合物(b)とする反応工程1と、線状部及び分岐部Yを有すると共に分岐部Yに前記活性基 V_1 とsuzukiクロスカップリング反応する2つの活性基 V_2 を有する下記化合物(c)と前記化合物(b)とをsuzukiクロスカップリング反応させて下記化合物(d)を得る反応工程2と、この生成物のチオフェン環の α 位水素をsuzukiクロスカップリング反応する活性基 V_1 に変換すると共にこれに下記化合物(c)を反応させて次世代のデンドロンを得る反応工程3と、この反応工程3を必要に応じて繰り返してデンドリマーとする工程とを具備することを特徴とするデンドリマーの製造方法にある。

$$R_1$$
 R_2 (1)

$$A = \begin{bmatrix} S & Z & Y_1 & W \end{bmatrix}_{n}$$

$$R_1$$
 R_2 V_2 V_2 V_2 V_2

5 (式中Zは、置換基を有してもよい活性基を含まない2価の有機基又は単結合であり、 R_1 、 R_2 は、水素、アルキル基及びアルコキシ基から選択される。また、Yは、置換基を有してもよい3価の有機基であり、 Y_1 は、Yと同一又はYと同一骨格を有する有機基である。Wは、置換基を有してもよい活性基を含まない1価の有機基であり、存在しなくてもよく、mは0又は1以上の整数である。



活性基 V_1 及び V_2 は、互いにsuzukiクロスカップリング反応する活性基から選択される。)

本発明の第2の態様は、第1の態様において、前記活性基 V_1 が下記グループ 1から選択され且つ前記活性基 V_2 が下記グループ 2から選択されることを特徴 とするデンドリマーの製造方法にある。

R=メチル, エチル, イソプロピル, ブチル

グループ2

C1, Br, I, OSO₂ (
$$C_k F_{2k+1}$$
)
 $k=1 \sim 4$

本発明の第3の態様は、第1の態様において、前記活性基 V_1 が下記グループ 3から選択され且つ前記活性基 V_2 が下記グループ 4から選択されることを特徴 2 とするデンドリマーの製造方法にある。

グループ3

Cl, Br, I



グループ4

---B(OH)2

---B(OR)2

5

10

R=メチル, エチル, イソプロピル, ブチル

本発明の第4の態様は、第1~3の何れかの態様において、前記Suzukiクロスカップリング反応を行う際に用いる化合物のうちの一方がホウ素を含むチオフェン系有機ホウ素化合物の場合、このチオフェン系有機ホウ素化合物を、他方の化合物が含まれる反応系へ、徐々に連続的又は断続的に添加してSuzukiクロスカップリング反応させることを特徴とするデンドリマーの製造方法にある。

本発明の第5の態様は、第1~4の何れかの態様において、前記反応工程3により又は前記反応工程3を繰り返すことにより得た下記一般式 (e) の化合物のチオフェン環の α 位水素を前記活性基 V_1 に変換して下記化合物 (f) とし、この化合物 (f) とコアとなる Y_2 を有する下記化合物 (g) とを反応させて下記一般式 (2) で表される化合物とする反応工程を具備することを特徴とするデンドリマーの製造方法にある。

$$Y_2 - V_2$$
 (g)

5 (式中、Y₂はr価の有機基を表し、rは1以上の整数である。)

本発明の第6の態様は、チエニレン構造を含む繰り返し構造単位を有するデンドリマーをConvergent法により製造するデンドリマーの製造方法に用いられるビ

ルディングブロックであり、下記一般式(I-1)で表わされることを特徴とする化合物にある。

$$R_3$$
 R_4 V_3 V_3

(上記一般式(I-1)中、pは $1\sim10$ の整数を表わし、 R_3 、 R_4 は、水素 、 アルキル基、アルコキシ基から選択される。pが $2\sim10$ の場合、チエニレン の繰り返し単位ごとに R_3 、 R_4 が異なっていても良い。 V_3 は下記グループ 5 から選択される)。

グループ5

CI, Br, I,
$$OSO_2(C_kF_{2k+1})$$

k=1~4

 $--B(OH)_2$

---B(OR)2

R=メチル, エチル, イソプロピル, ブチル

本発明の第7の態様は、下記一般式 (I-2) で表わされることを特徴とする 10 化合物にある。



H
$$R_7$$
 R_8 S_2 R_5 R_6 S_1 S_2 S_3 S_3

(上記一般式(I-2)中、 $S_1 \sim S_3$ は $1 \sim 10$ の整数を表わし、それぞれ同一であっても異なっていてもよい。 $R_5 \sim R_1$ 。は、水素、アルキル基、アルコキシ基から選択され、チエニレンの繰り返し単位ごとに $R_5 \sim R_1$ 。が異なっていても良い。 V_4 は下記グループ 6 から選択される。)

グループ6

Cl, Br, I

5

 $-B(OH)_2$

 $--B(OR)_2$

R=メチル, エチル, イソプロピル, ブチル

本発明の第8の態様は、下記一般式(I-3)で表わされることを特徴とする

化合物にある。

$$V_5$$
 R_{11}
 R_{12}
 Q
 $(I-3)$

(上記一般式(I-3)中、qは $1\sim10$ の整数を表わし、qが $2\sim10$ の場合、チエニレンの繰り返し単位ごとに R_{1-1} , R_{1-2} が異なっていても良い。 V_5 は下記グループ 7 から選択される。)

グループ7

H, Cl, Br, I

 $-B(OH)_2$

 $-B(OR)_2$

R=メチル, エチル, イソプロピル, ブチル

本発明の第9の態様は、チオフェン系有機ホウ素化合物と反応性化合物とをS

uzukiクロスカップリング反応させてチオフェン系化合物を得るチオフェン系化合物の製造方法において、前記反応性化合物が含まれる反応系に、前記チオフェン系有機ホウ素化合物を、徐々に連続的又は断続的に添加してSuzukiクロスカップリング反応させることを特徴とするチオフェン系化合物の製造方法にある。

本発明の第10の態様は、第9の態様において、前記チオフェン系有機ホウ素・化合物が下記グループ1から選択される活性基 V_6 を有し、且つ前記反応性化合物が下記グループ2から選択される活性基 V_7 を有することを特徴とするチオフェン系化合物の製造方法にある。

R=メチル, エチル, イソプロピル, ブチル

10

5

グループ2
C1, Br, I, OSO₂ (
$$C_k F_{2k+1}$$
)
 $k=1\sim 4$

本発明を実施するための最良の形態

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明方法により製造されるデンドリマーとは、一般的に定義されるデンドリマーの合成法であるConvergent法で製造されるデンドリマーであり、重合法で合

10

20



成されるハイパーブランチポリマーを含まない概念であり、上述した一般式(1)の繰り返し構造単位、すなわちデンドリック構造単位を少なくとも2段以上繰り返した構造を有するものを全て包含する。なお、この一般式(1)の繰り返し単位を含んだ構造、すなわち、繰り返し単位を分岐状に繰り返して連結した構造を分岐構造という。

デンドリマー及びハイパーブランチポリマーは、一般的には下記式に示すように分類され、分岐構造が規則的であるものをデンドリマー、分岐構造が規則的でないものをハイパーブランチポリマーといい、本発明により製造されるのは前者のデンドリマーであって、1つの開始点から樹木状に分岐した構造か、複数の開始点をコアとなる多官能高分子に結合して放射状に分岐した構造かは問わない。勿論、これとは異なる定義もあるが、何れにしても、本発明方法で製造されるのは、分岐構造が規則的なデンドリマーであり、樹木状分岐構造のもの、放射状分岐構造のものを包含するものであるが、勿論、一般的なConvergent法による製造工程によって分岐構造に欠陥が生じた化合物も包含するものである。

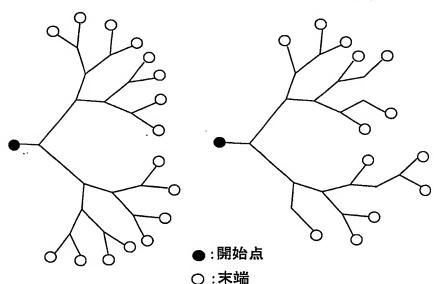
15 また、一般的な定義では、完全にデンドリック構造単位が繰り返された場合を 世代というが、基本的な構造が同一であるが類似するデンドリック構造単位を 2 段以上連結した構造も本発明のデンドリマーに含むものとする。

なお、デンドリマー、ハイパーブランチポリマーなどの概念は、柿本雅明,化学,50巻,608頁(1995)、高分子,Vol. 47,P. 804(1998)等に記載されており、これらを参照することができるが、これらに記載されたものに限定されるものではない



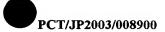
デンドリマ・

ヽイパーブランチポリマー



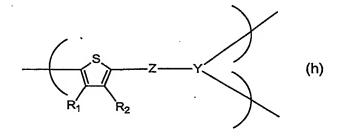
〇:末端

本発明方法により製造されるデンドリマーにおいて、デンドリック構造単位は 、上記一般式(1)に表されるようにチエニレン構造を含む線状部と置換基を有 してもよい3価の有機基である分岐部Yとからなり、これを2段繰り返した構造 5 とは、分岐部Yの結合手のそれぞれに、同一のデンドリック構造単位が結合した 構造をいい、これを第1世代デンドロンという。また、第1世代デンドロンの分

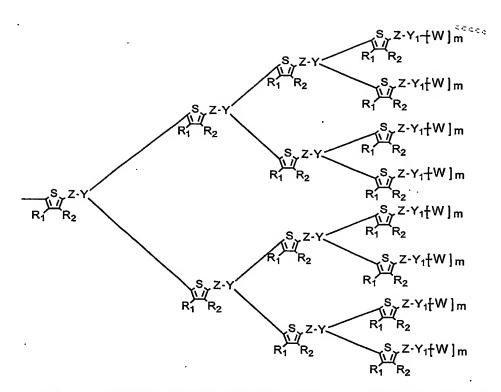


岐部Yの結合手に順次同一のデンドリック構造単位が結合したものを第2世代、・・・第n世代デンドロンといい、このもの自体、又はこの末端や開始点に所望の置換基を結合させたものを樹木状分岐構造のデンドリマー、また、これをサブコニットとし、同一又は非同一の複数のサブユニットを複数価の核(コア)に結合させたものを放射状分岐構造のデンドリマーという。

ここで、一般式(e)、(f)及び(2)で表される化合物において、デンドリック構造単位を囲む括弧、すなわち、下記式(h)で示す構造は、デンドリック構造単位が任意の数だけ繰り返されて、規則的に制御された又は必ずしも完全には制御されない樹木状分岐構造が形成されていることを示す。したがって、一般式(e)、(f)及び(2)で表される化合物において分岐構造の繰り返し回数がnである場合、第n世代となる。但し、これは単なる世代の呼び方であり、このように呼ばれるものに限定されるものではない。



本発明方法で製造されるデンドリマーの具体例としては、下記式で表される化 15 合物を挙げることができる。



ここで、分岐部Yは3価の基であるが、Zとの結合手でない他の結合手が、同一の原子又は原子団に存在する場合と異なった原子又は原子団に存在する場合がある。

-方、 Y_1 は、Yと同一又はYと同一骨格を有する有機基であるが、「Yと同一又はYと同一骨格を有する有機基」とは、少なくともZとの結合側にYと同一又は同一骨格の構造が存在することを示し、例えば、Zと結合するYが下記式(A)で示される場合には、 Y_1 としては下記(B)や(C)や(D)が例示できる。

10

$$(Z) \longrightarrow (Z) \longrightarrow (Z) \longrightarrow (D)$$

$$(Z) \longrightarrow (D)$$

$$(Z) \longrightarrow (D)$$

(mは1~5の整数であり、Qは任意の置換基を示す。)

また、本発明方法により製造されるデンドリマーは、分岐点の数の制限はない

10

本発明は、一般式(1)に示すように、そのデンドリック構造単位がチエニレン構造を含む線状部と分岐部Yからなり、線状部は少なくとも1つのチエニレン構造を含む2価の有機基であるデンドリマーであって、下記反応式(I)で示される反応工程からなり、必要に応じて反応工程3を繰り返すことにより所望の世代のデンドロンを合成可能な、当該デンドリマーを製造する方法に関する。なお、式中 V_1 及び V_2 はSuzukiクロスカップリング反応する活性基、Z は、置換基を有してもよい活性基を含まない2 価の有機基又は単結合であり、 R_1 、 R_2 は、水素、アルキル基及びアルコキシ基から選択される。ここで、この明細書において、特に限定しない場合には、アルキル基及びアルコキシ基等は炭素数が $1\sim 2$ 0のものを示すものとする。また、Yは、置換基を有してもよい3 価の有機基であり、 Y_1 は、Yと同一又はYと同一骨格を有する有機基、Wは置換基を有してもよい活性基を含まない1 価の有機基であり、存在しなくてもよく、mは0 又は1 以上の整数である。

反応式 (I)

10

15



上記反応式(I)で表される反応工程は、チオフェン環の α 位水素を活性基V $_1$ に置換する反応工程 1 、 V_1 と V_2 をSuzukiクロスカップリング反応で結合させて世代を成長させる反応工程 2 、さらに世代を成長させるために反応工程 2 の 生成物(d)のチオフェン環の α 位水素を活性基 V_1 に置換すると共にこれに化合物(c)を反応させる反応工程 3 と、必要に応じて反応工程 3 を繰り返す工程 からなる。なお、Wは製造されるデンドリマーの末端基となる。

反応式(I)において、反応工程2で使用するデンドリマーのビルディングブロックとなる化合物(c)としては、上記一般式(I-1)又は(I-2)で示される化合物が好適に利用できる。一般式(I-1)及び(I-2)で示される化合物の合成方法に特に制限はないが、対応するチオフェン誘導体とベンゼン誘導体のカップリング反応や活性基となるハロゲン又はホウ素系置換基の導入反応を組み合わせることで合成することができる。カップリング反応には、Grignar ard 反応やStilleカップリング反応も利用できるが、本発明の製造方法と同様にSuzukiクロスカップリング反応が好適に利用できる。

また、反応式(I)において、反応工程1の原料である化合物(a)の合成法 に特に制限はないが、例えば、下記反応式(II)に示される反応工程、すなわち 、 V_1 と V_2 の反応により末端基となるWを Y_1 に結合させる反応工程で、化合 物(a)を得ることができる。

反応式(II)

20 なお、末端部にホール伝導材料であるトリアリールアミン骨格を導入する場合 、化合物(a)としては、上記一般式(I-3)で示される化合物が好適に利用 できる。その合成方法に制限はないが、前記式(II)において、 Y_1 をベンゼン 核とし、 V_2 がハロゲンで、 V_1 -Wが下記式で表わされる 2級アリールアミン 化合物との縮合反応が好適に利用できる。



この反応としては、銅と塩基触媒を用いるUllmann縮合(Chem. Lett., 1145, (1989)、Synth. Commu383, (1987)等、参照)や、パラジウム触媒とトリーtーブチルホスフィン配位子の組合せ及び塩基触媒を用いる東ソー法(特開平10-310561号公報)が利用でき、温和な条件下で行なえ収率や選択性が高いことから、後者の方法が好適である。この反応の利用により、例えば下記式で表わされるような反応様式により、トリアリールアミン骨格が構築できる。

10 また、反応式 (II) の化合物 (m) としては、前記一般式 (I-1) で示される化合物が好適に利用できる。

反応式(I)及び(II)における V_1 及び V_2 の反応は、いずれもSuzukiクロスカップリング反応を使用するが、Suzukiクロスカップリング反応は、官能基に対する制約が少なく、反応の選択性も高くホモカップリングなどの副反応が少ないことが知られており、特に芳香族化合物やビニル化合物誘導体のクロスカップリング反応に広く利用されているため(鈴木ら,有機合成化学協会誌,46,848, (1988)、鈴木ら,Chem. Rev.,95,2457 (1995)、鈴木,J. Organomet. Chem.,576,147 (1999)参照)、本発明の製造方法によりデンドリマーは幅広い骨格の選択が可能である。

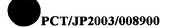
20 上記反応式(I)及び(II)においてV,及びV。はSuzukiクロスカップリン

10

15

20

25



グ反応により互いに反応する基である。なお、この置換基 V_1 及び V_2 の組合せは、各反応工程において他の反応工程からそれぞれ独立に選択することができる。以下に好適な組合せを例示する。

 V_1 及び V_2 の第1の組合せとしては、 V_1 が上記グループ1から選択され且 OV_2 が上記グループ2から選択される組合せがある。反応収率や選択性の高さ、さらに汎用性の高さなどから、 V_1 がB $(OH)_2$ またはB $(OR)_2$ で表わされるホウ酸エステル型の置換基で、 V_2 がB r またはI である場合の組合せが好適に利用できる。この場合の上記反応式におけるYは置換基を有してもよい3 価の有機基であり、例えば、 V_2 基に結合する部分がアリル、アルケニル、アルキニル、ベンジル、アリール、アルキルである構造や複素環基を含む構造を有する3 価の基を挙げることができる。また、当該デンドリマーの末端基となるWは、置換基を有してもよい活性基を含まない1 価の有機基で、存在しなくてもよいが、ここで「活性基を含まない」とは、Suzukiクロスカップリング反応に関与する基を含まないことを意味する。Wとしては例えば、置換または非置換のアリール、アルケニル、アルキル基等を挙げることができる。

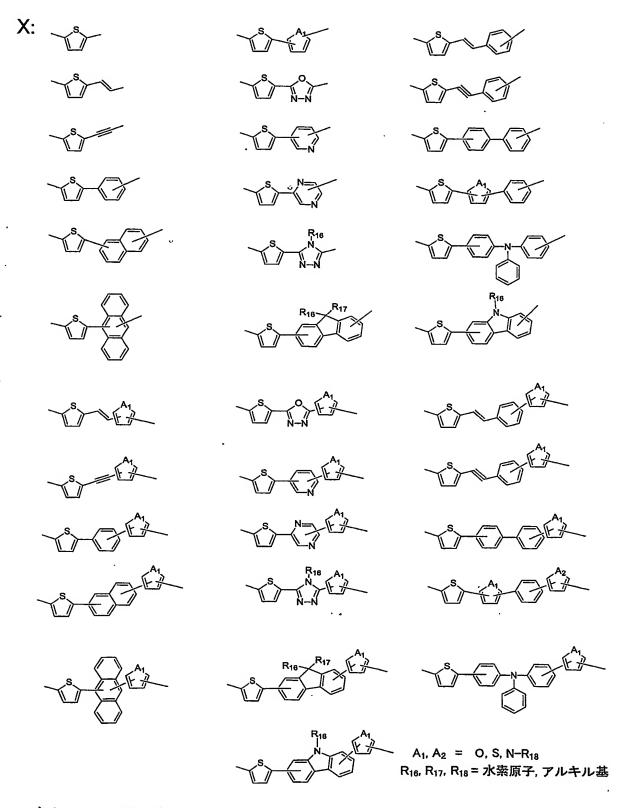
第2の組合せとしては、 V_1 が上記グループ3から選択され且つ V_2 が上記グループ4から選択される組合せがある。この場合の上記反応式におけるYは置換基を有してもよい3価の有機基であり、例えば、 V_2 基に結合する部分がアリール、アルケニル、アルキルである構造や複素環基を含む構造を有する3価の基を挙げることができる。また、当該デンドリマーの末端基となるWは、置換基を有してもよい活性基を含まない1価の有機基で、存在しなくてもよいが、ここで「活性基を含まない」とは、Suzukiクロスカップリング反応に関与する基を含まないことを意味する。Wとしては例えば、置換または非置換のアリル、アルケニル、アルキニル、ベンジル、アリール、アルキル基等を挙げることができる。

なお、上記第1又は2の組合せにおいて、Yは3価の有機基、Y₁はYと同一又はYと同一骨格を有する有機基であり、また、Zは置換基を有してもよい活性基を含まない2価の有機基又は単結合である。ここで「活性基を含まない」とは、Suzukiクロスカップリング反応に関与する基を含まないことを意味する。なお、前記第1の組合せの場合、ハロゲン化による活性基導入の反応工程が不要であ

り、目的とする活性基導入点以外に、ハロゲン化試剤に対する活性を有する骨格 あるいは置換基が存在する場合にも、好適に利用できる。

Y及びX (Xはーチオフェン環-Z-を表す)の好ましい例を以下に示す。





なお、Y及びZが、チエニレンと少なくとも部分的に共役しているものとすると、製造されるデンドリマーは半導体性となる。ここでいう少なくとも部分的に



共役するとは、完全共役系だけではなく、π電子系が全て非局在化していない共 役系も含むことを意味し、例えばベンゼン核のメタ配位が含まれる共役系の場合 も含まれる。

以下にチオフェン環の α 位水素を活性基 V_1 に変換する反応、及び活性基 V_2 と V_2 の反応の条件の一例について述べる。

[チオフェン環の α位水素を活性基V, に変換する反応]

反応工程1および反応工程3において、チオフェン環の α 位水素を上記グループ1から選択される活性基 V_1 に変換する反応の反応条件の一例について記述する。

10 V_1 がB(OR) $_2$ 又は下記式で表わされるホウ酸エステルである場合には、例えば、nーブチルリチウムに代表されるアルキルリチウムやリチウムジイソプロピルアミド等を作用させチオフェン環の α 位水素を引き抜きカルボアニオンとした後、対応するアルコキシボラン、すなわちトリメトキシボラン、トリエトキシボラン、トリイソプロポキシボラン、トリブトキシボラン又は2ーイソプロポキシボラン、トリブトキシボラン又は2ーイソプロポキシー4, 4, 5, 5ーテトラメチルー1, 3, 2ージオキサボロランを求電子付加させる。

20

25

溶媒としてはテトラヒドロフラン、n-ヘキサン、ジエチルエーテル、トルエン等の有機溶媒が好適に利用できる。反応温度は-100~30℃が好ましく、より好ましくは-78~0℃である。反応時間は、10分~3時間が好ましく、より好ましくは30分~2時間である。

 V_1 が B (OH) $_2$ である場合には、上記の方法で得られたホウ酸エステル類に水を添加して加水分解する。反応溶媒は特に限定されないが、製造上、上記の方法でホウ酸エステルを合成した反応混合物に、直接水を加えて加水分解することが簡便である。反応温度は $0\sim5$ 0 \mathbb{C} が好ましく、反応時間は 1 時間 ~3 時間が好ましい。

10

20

25



反応工程 1 および反応工程 3 において、チオフェン環の α 位水素を上記グループ 3 から選択される活性基 V_1 に変換する反応の反応条件の一例について記述する。

 V_1 がC1、BrまたはIのいずれの場合においても、対応するハロゲン化試薬を作用させ、チオフェン環の α 位水素をハロゲン置換する。ハロゲン化試薬としては、例えば、Nークロロスクシンイミド、NープロモスクシンイミドやNーヨードスクシンイミド等が挙げられる。反応溶媒としてはテトラヒドロフラン、n-キサン、ジエチルエーテル、ベンゼン、四塩化炭素、二硫化炭素、ジメチルホルムアミド、酢酸等の有機溶媒が好適に利用できる。反応温度は、-20~80℃が好ましく、反応時間は1時間~24時間が好ましい。

[活性基V₁とV₂とのSuzukiクロスカップリング反応]

反応工程 2 および 3 において、Suzuki クロスカップリング反応により、 V_1 と V_2 を反応させる反応条件の一例について記述する。

Suzukiクロスカップリング反応においては、反応に用いる触媒としては、種々 15 のパラジウム触媒と塩基触媒の組合せが利用できる。

パラジウム触媒としては、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、酢酸パラジウム、塩化パラジウム、パラジウム黒、ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウムジクロリド、ビス(トリーoートシルホスフィン)パラジウムジクロリド、ビス(ドリーoートシルホスフィン)パラジウムジクロリド、ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム、ビス(トリシクロへキシルホスフィン)パラジウムジクロリド、ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウムジアセタート、 [1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン [1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン [1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン [1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン [1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ) [1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ) [1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ) [1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ) [1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ) [1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ) [1, 3-ビス(ジフェニルホスフィノ) [1, 3-ビス(シーフェニルホスフィン、トリンクロへキシルホスフィン、トリ(2-フリル) [1, 3-ビス(トリンクロへキシルホスフィン、トリス(2, 6-ジメトキシフェニル) [1, 3-ビス(トリンクロへキシルホスフィン、トリス(2, 6-ジメトキシフェニル) [1, 3-ビス(トリンクロへキシルホスフィン、トリス(2, 6-ジメトキシフェニル) [1, 3-ビス(1, 13-ビス(1, 13-ビス)) [1, 3-ビス(1, 13-ビス)) [1, 3-ビス(1, 13-ビス)) [1, 3-ビス(1, 13-ビス)) [1, 3-ビス)) [1, 3-ビス(1, 13-ビス)) [1, 3-ビス(1, 13-ビス)) [1, 3-ビス)) [1, 3-ビス(1, 13-ビス)) [1, 3-ビス)) [1, 3-ビス))



フィン、トリス(4ーメトキシフェニル)ホスフィン、トリス(4ーメチルフェニル)ホスフィン、トリス(3ーメチルフェニル)ホスフィン、トリス(2ーメチルフェニル)ホスフィン等が挙げられる。またパラジウム触媒の代わりにニッケル触媒の[1,1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]ニッケルジクロリド、ビス(トリシクロヘキシルホスフィノ)ニッケルジクロリド、塩化ニッケル・六水和物を使用することもできる。

塩基触媒としては、炭酸ナトリウム、ナトリウムエトキシド等のナトリウムアルコキシド類、 t ープトキシカリウム、水酸化バリウム、トリエチルアミン、リン酸カリウム、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等が挙げられる。

10 また、Suzukiクロスカップリング反応の場合、溶媒としては種々の有機溶媒と その混合溶媒、それらの有機溶媒と水との混合溶媒が一般的に用いられ、有機溶 媒としてはジメチルホルムアミド、エタノール、メタノール、ジメチルスルホキ シド、ジオキサン、ベンゼン、トルエン、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタ ン、ジメチルアセトアミド、キシレン、1-プロパノール、2-プロパノール、 2ーメチルー1ープロパノール、2ーメチルー2ープロパノール、1ーブタノー 15 ル、2-ブタノール、アセトン、2-ブタノン、3-メチル-2-ブタノン、2 ーペンタノン、3ーペンタノン、4ーメチルー2ーペンタノン、2ーメチルー3 ーペンタノン、 2、 4 ージメチルー 3 ーペンタノン、ジオキソラン、N ーメチル ピロリドン、ジエトキシエタン、エチレングリコール、エチレングリコールモノ 20 メチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコール エチルメチルエーテル、ジエチレングリコール、ジエチレングリコールモノメチ ルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール ジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコ ールエチルメチルエーテル、メシチレン、エチルベンゼン、アニソール、ニトロ 25 ベンゼン、テトラメチルウレア等が好適に利用できる。なお反応温度は、25~ 150℃が好ましく、より好ましくは25~80℃であり、反応時間は、30分 ~24時間が好ましく、より好ましくは1~12時間である。

なお、反応式 (II) に示される反応工程、すなわち、 V_1 と V_2 の反応により 末端基となるWを Y_1 に結合させて、反応工程1 の原料である化合物 (a) を得



る反応工程においても、反応条件例は上述の反応工程2及び3と同様である。

また、反応工程3により又は反応工程3を繰り返すことで所望の世代数まで成長させた後、核(コア)に結合させることもできる。これにより、一般式(2)で示されるデンドリマーを得ることができる。なお、 Y_2 はr 価の有機基(r は 1以上の整数)であり、化合物(2)におけるr は中心構造からの分岐数を表す次数である。その他の記号は上述の通りである。ここで、r が 2以上の場合は放射状分岐構造のデンドリマーとなる。r が 1 の場合には、樹木状分岐構造のデンドリマーとなるが、この場合でも Y_2 をコアとよぶものとする。

具体的には、下記反応式(III)に示すように、反応工程3により又は反応工程3を繰り返すことにより得た一般式(e)で示される化合物のチオフェン環の α 位水素を活性基 V_1 に変換して化合物(f)とし、この化合物(f)とコア(核)となる Y_2 を有する化合物(g)とを反応させる。なお、この反応においても、チオフェン環の α 位水素を活性基 V_1 に変換する反応や V_1 及び V_2 の反応は、上述の反応工程 $1\sim3$ と同様である。

15

10

5

反応式 (III)

H

$$R_1$$
 R_2
 R_1
 R_2

この反応により、あらゆる世代数のデンドリマーも、同様の反応工程により中 心構造分子に結合させることができる。だだし、デンドリック構造単位の密集性 と合成の容易性からデンドリマーの世代数は1~10が好ましく、より好ましく

10

15

20



は $1\sim8$ 、さらに好ましくは $1\sim7$ 、最も好ましいのは $2\sim5$ であり、また、中心構造からの分岐数は $1\sim6$ が好ましく、さらに好ましくは $1\sim4$ である。

また、所望の世代数まで成長させる途中または核に結合させた後、末端基Wを 化学修飾することで、デンドリマーの最外殻に新たな構造を導入することもでき る。

さらに、上記した工程毎に精製処理を行なうことで、欠陥の少ない高純度のデ ンドリマーが合成できる。精製方法は特に限定されないが、再結晶、晶析、昇華 精製、カラム精製等が例示される。

本発明の製造方法によれば、末端部分を構成する化合物(a) およびデンドリック構造の単量体単位となる化合物(c) および中心構造となる化合物(g) を選択することで、種々のデンドリマーが製造できる。さらに、反応工程毎に精製処理を行なうことが容易な「Convergent法」を利用しているため、欠陥の少ない高純度のデンドリマーも製造可能である。

以上説明したデンドリマーの製造方法において適用した、チオフェン系有機ホウ素化合物と反応性化合物とのSuzukiクロスカップリング反応においては、チオフェン系有機ホウ素化合物が反応系内で加水分解されやすいこと、及び、チオフェン系有機ホウ素化合物を反応性化合物が含まれる反応系中に徐々に連続的又は断続的に添加することで、分解を抑制しSuzukiクロスカップリング反応を優先的に進行させることができることを知見した。すなわち、チオフェン系有機ホウ素化合物と反応性化合物とをSuzukiクロスカップリング反応させてチオフェン系化合物を得る際に、反応性化合物が含まれる反応系に、チオフェン系有機ホウ素化合物を、徐々に連続的又は断続的に添加してSuzukiクロスカップリング反応させることにより、高収率でチオフェン系化合物を得ることができる。ここで、チオフェン系化合物とは、チオフェン環を有する化合物である。

25 チオフェン系有機ホウ素化合物としては、例えば、グループ1から選択される 活性基V。を有するチオフェン系有機化合物、反応性化合物としてはグループ2 から選択される活性基V。を有する化合物が挙げられる。

以下この反応について詳述する。

Suzukiクロスカップリング反応において、必要な原料の全量を仕込んで反応を

10

15

20

25



開始すると、パラジウム等の金属触媒と塩基触媒による酸化付加ートランスメタル化一還元脱離という目的の反応サイクルと、チオフェン系有機ホウ素化合物の加水分解反応が競争的に進行すると考えられる。しかしながら、チオフェン系有機ホウ素化合物を徐々に反応系中に添加する、例えば滴下すると、添加されたものから速やかに目的の反応が進行するため、加水分解が抑制されると考えられ、それにより収率を向上させることができる。この滴下等、徐々にする添加は、連続的に行ってもよく、断続的に行ってもよい。この場合、チオフェン系有機ホウ素化合物を除く全ての原料を全量仕込んだ反応系中にチオフェン系有機ホウ素化合物を徐々に連続的又は断続的に添加すればよい。

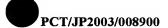
また、複数の反応点を持つ化合物とチオフェン系有機ホウ素化合物とをカップリング反応させる場合、立体障害や電子的な影響によって反応速度が低下し、余剰の塩基により加水分解されやすくなる場合もあるので、必要に応じて塩基触媒も徐々に連続的又は断続的に添加してもよい。例えば、デンドロンの世代成長反応の場合は、分岐部を有する化合物に反応点が隣接して2点存在するため、まず、1点分に相当する塩基触媒の存在下、チオフェン系有機ホウ素化合物を徐々に連続的又は断続的に添加した後、もう1点分の塩基触媒を加えてチオフェン系有機ホウ素化合物を徐々に連続的又は断続的に添加する方法や、塩基触媒と有機ホウ素化合物を同時に連続的に添加する方法等が挙げられる。

なお、チオフェン系有機ホウ素化合物以外の分解しやすい化合物についても、 上記チオフェン系有機ホウ素化合物と同様に、徐々に連続的又は断続的に反応系 に添加するようにすると、収率を向上させることができる。

以下に、反応条件の一例について述べる。

チオフェン系有機ホウ素化合物が固体の場合は、溶媒に溶かし溶液とすると連続的に添加し易く、溶媒へ溶解し難い場合は固体又は液体のまま添加すればよい。溶媒としては前記の反応溶媒が好適に利用できる。また、反応に影響がなければチオフェン系有機ホウ素化合物を調製した反応液をそのまま使用してもよい。連続的に添加する場合の添加速度は特に制限はないが、15分~5時間が好ましく、より好ましくは30分~2時間である。断続的に添加する場合の、1回の添加量と添加間隔に特に制限はないが、理論量を5~50に分割した量を1回の添加量と添加間隔に特に制限はないが、理論量を5~50に分割した量を1回の添

25



加量として、理論量の全量を15分~5時間、より好ましくは30分~2時間で 断続的に添加することが好ましい。塩基触媒を徐々に連続的又は断続的に添加す る場合も同様であり、添加のタイミングはチオフェン系有機ホウ素化合物を同時 か、それよりも先に添加することが好ましい。また、連続的添加法と断続的添加 法を組み合わせてもよく、例えば所定量の半分となる塩基触媒の存在下に、同様 に所定量の半分となるチオフェン系有機ホウ素化合物を連続的に添加して反応さ せた後、残りの半分の塩基触媒を添加し、そこに残り半分のチオフェン系有機ホ ウ素化合物を連続的に添加する方法等が挙げられる。添加時の温度は前記の反応 温度と同様である。

10 この方法を本発明のデンドリマーの製造方法に適用した場合は、活性基 V_1 又は V_2 にホウ素が置換している有機ホウ素化合物を、もう一方の活性基を有する化合物、塩基触媒、反応溶媒および金属触媒を含む反応系へ、徐々に連続的又は断続的に添加すればよい。例えば、活性基 V_1 がグループ1から選択される化合物を、活性基 V_2 がグループ2から選択される化合物が含まれる反応系へ、徐々に連続的又は断続的に添加してSuzukiクロスカップリング反応させるか、又は、活性基 V_2 がグループ4から選択される化合物を、活性基 V_1 がグループ3から選択される化合物が含まれる反応系へ、徐々に連続的又は断続的に添加してSuzukiクロスカップリング反応させる。

このように、チオフェン系有機ホウ素化合物を徐々に連続的又は断続的に添加 20 する方法を、本発明のデンドリマーの製造方法に適用すると、高収率で目的とす るデンドリマーを得ることができる。

本発明のデンドリマーを以下に示す実施例に基づいて説明する。ただし、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。なお、測定に用いた装置等は以下の通りである。

¹ H-NMR: JEOL製JNM-AL400型FT-NMR(400MHz)、溶媒: CDC1₃ 又はDMSO-d⁶、室温測定、ケミカルシフトの基準(0ppm)はテトラメチルシラン(TMS)とした。

GPC:東ソー(株)製HLC-8220GPC、カラム:TSKgelSu



perHZM-M、溶離液:THF、検出器:UV254nm、測定値(重量平均分子量Mw、数平均分子量Mn、分子量分布Mw/Mn)は標準ポリスチレン換算による値である。

(合成実施例1) 第3世代デンドリマーの合成

5 (合成実施例1-1) デンドリック構造の単量体単位の化合物(c)となる、下記式で示される5-(3,5-ジブロモフェニル)-2,2'-ビチオフェンの合成

窒素雰囲気下、2,2'ービチオフェン4.6gを脱水テトラヒドロフランに 溶解し、ドライアイスーメタノール浴中で冷却した。冷却後、1.6Mーnーブ チルリチウム/ヘキサン溶液18mlを滴下し、そのまま1時間反応させた。続いてトリメトキシボラン3.4gを滴下し、そのまま1時間反応させた。反応終了後、水を添加し加水分解させた後、冷却浴をはずして室温へ温度を上げた。反 応混合物に飽和塩化アンモニウム水溶液及びジエチルエーテルを添加し、撹拌、

静置してから有機層を分離した。さらに水層をテトラヒドロフラン/ジエチルエーテル(1/2容量比)混合溶媒で抽出し、先の有機層をあわせた。得られた有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した。さらに硫酸ナトリウムで乾燥処理を行なった後、溶媒を減圧留去して粗製物を得た。粗製物をテトラヒドロフラン/n-0キサンで再結晶し、下記式で表される中間体化合物 2, 2' ービチオフェン-5ーボロン酸 4.3 g (淡青白色固体)を収率 7 3%で得た。

15

20

その構造は¹ H-NMRスペクトルにて確認した。測定データを以下に示す。

10

15

20

 1 H NMR(DMSO-d⁶) δ 8.30(s, BOH, 2H), δ 7.60(d, J = 3.6Hz, チオフェン環, 1H), δ 7.51(dd, J = 5.2Hz, J = 1.2 Hz, チオフェン環, 1H), δ 7.34-7.32(m, チオフェン環, 2H), δ 7.10(dd, J = 5.2Hz, J = 3.6Hz, チオフェン環, 1H).

次に、窒素雰囲気下、得られた中間体化合物 2、2′ービチオフェンー 5ーボロン酸 4.0 g及び 1、3、5ートリプロモベンゼン 9.0 gをテトラヒドロフランに溶解した。この溶液に酢酸パラジウム 0.1 g、トリフェニルホスフィン 0.30 gを加え、さらに水 3 4 m 1 に溶解した炭酸ナトリウム 4.4 gを添加し80℃の油浴中で 6 時間加熱撹拌しながら反応させた。反応終了後、室温まで冷却し、水 3 0 m 1 を添加した。得られた反応混合物を塩化メチレンで抽出し、得られた有機層を水で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理し、溶媒を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck製 Silicagel 60、溶離液:塩化メチレン/nーへキサン)により単離精製し、目的物 4.6 g(淡黄色固体)を収率 61%で得た。その構造は 1 H NMRスペクトルにて、確認した。測定データを以下に示す。

¹H NMR (CDCl₃) δ7.65 (d, J = 1.6Hz, ベンゼン環, 2H), δ7.55 (t, J = 1.6Hz, ベンゼン環, 1H), δ7.26-7.25 (チオフェン環, 1H), δ7.23 (d, J = 3.6Hz, チオフェン環, 1H), δ7.15 (d, J = 3.6Hz, チオフェン環, 1H), δ7.15 (d, J = 3.6Hz, チオフェン環, 1H), δ7.05 (dd, J = 5.2Hz, J = 3.6Hz, チオフェン環, 1H).

(合成実施例1-2) デンドリック構造の末端部分を構成する化合物 (a) となる、下記式で示される5-[2, 2']ビチオフェニル-5-イル-N, N', N'-テトラフェニル-1, 3-フェニレンジアミンの合成



〈触媒の調製〉

酢酸パラジウム10mgにキシレン4.5m1を加え、窒素雰囲気下、トリー t ーブチルホスフィン36mgを添加後、80℃で30分間加熱して、触媒溶液 を得た。

5 〈5-[2, 2']ビチオフェニル-5-イル-N, N, N', N'-テトラフェニル-1, 3-フェニレンジアミンの合成〉

合成実施例1-1で得られた5-(3,5-ジブロモフェニル)-2,2'-ビチオフェン1.80g、ジフェニルアミン1.60gおよびtーブトキシカリウム1.21gにキシレン4.5mlを加え、窒素雰囲気下、80℃で先に調製した触媒溶液を滴下した。滴下終了後、120℃に温度を上げ、そのまま18時間反応させた。反応後、室温まで冷却して水10mlを添加した。有機層を分離し、水層は塩化メチレンで抽出して、先の有機層と合わせた。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理し、溶媒を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck製 Silicagel 60,溶離液:塩化メチレン/n-ヘキサン)により単離精製し、目的物2.20g(淡黄色固体)を収率85%で得た。その構造は1H-NMRスペクトルにて確認した。測定データを以下に示す。

 1 H NMR(CDCl $_3$) δ 7. 22(t, J = 7. 8Hz,ベンゼン環,8H), δ 7. 16(dd,J = 1. 2Hz,J = 5. 2Hz,チオフェン環,1H), δ 7. 11-7. 09(m,チオフェン環,1H および ベンゼン環,8H), δ 7. 02-6. 96(m,ベンゼン環,4H および チオフェン環,3H), δ 6. 90(d,J = 2. 0Hz,ベンゼン環,2H), δ 6. 73(t,J = 2. 0Hz,ベンゼン環,1H)

(合成実施例1-3) デンドリック構造の末端部分を構成する化合物(a) のチオフェン環のα水素を活性基B(OH)。に変換して化合物(b)とする、
 下記式で示される5-(5'-ボロン酸-[2, 2']ビチオフェニル-5-イル)-N,N,N',N'-テトラフェニル-1,3-フェニレンジアミンの合成

窒素雰囲気下、合成実施例1-2で得られた5-[2,2']ビチオフェニルー 5-1ルーN, N', N' ーテトラフェニルー1, 3-フェニレンジアミン 2.0gを脱水テトラヒドロフランに溶解し、ドライアイスーメタノール浴中で 冷却した。冷却後、10wt%-リチウムジイソプロピルアミド/n-ヘキサン 5 懸濁液4.5g(A1drich社製)を滴下し,そのまま1時間反応させた。続 いてトリメトキシボラン 0.5 gを滴下し、そのまま1時間反応させた。反応終 了後、水を添加し加水分解させた後、冷却浴をはずして室温へ温度を上げた。反 応混合物に飽和塩化アンモニウム水溶液及びジエチルエーテルを添加し、撹拌、 10 静置してから有機層を分離した。さらに水層をテトラヒドロフラン/ジエチルエ ーテル(1/2容量比)混合溶媒で抽出し、先の有機層をあわせた。得られた有機 層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した。さらに硫酸ナトリウムで乾燥処理を 行なった後、溶媒を減圧留去して粗製物を得た。粗製物をテトラヒドロフラン/ n-ヘキサンで再結晶し、目的物1.5 g (淡黄色固体)を収率70%で得た 。その構造は¹ H-NMRスペクトル(測定溶媒:DMSO-d⁶)にて、8.3ppm 15 付近にボロン酸のOHプロトンが観測されたこと、およびベンゼン環由来のプロ トンとチオフェン環由来のプロトンの積分比が目的構造と一致したことより確認 した。

(合成実施例1-4) 前記化合物(b)と(c)のSuzukiクロスカップリン 20 グ反応による、下記式(11)で示される第1世代デンドリマーの合成

10

15

20



(構造式中のaは、1H NMRスペクトルで積分値の基準としたプロトンHaの置換位置を示す。)

〈連続的又は断続的添加法を利用しないSuzukiカップリング反応〉

合成実施例1-3で得られた $5-(5'-\pi)$ で酸ー[2, 2']ビチオフェニ ν -5-イル) -N, N, N', N'-テトラフェニルー1, 3-フェニレンジ アミン1.30g、合成実施例1-1で得られた5-(3,5-ジブロモフェニ ν) -2, 2' -ビチオフェン0. 40g、パラジウム酢酸13mg、トリフェ ニルホスフィン46mgおよび炭酸ナトリウム0.22gに、窒素雰囲気下、T HF10m1と水2m1を加え、還流下で8時間反応させた。反応終了後、室温 まで冷却し、水20m1を添加した。得られた反応混合物を塩化メチレンで抽出 し、得られた有機層を水で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理し、溶 媒を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:M erck製 Silicagel 60, 溶離液:塩化メチレン/n-ヘキサン)により単離精製し、目的物 0.84g(淡黄色固体)を収率 60%で得た。そ の構造は¹ H-NMRスペクトル(測定溶媒: CDCl₃)にて、6.74ppmに観 測される窒素原子が2つ隣接したベンゼン環プロトンHaを基準(2H分。式(11)参照。以下、その他の世代についてもHaは窒素原子が2つ隣接したベン ゼン核プロトンを示す)とし、ベンゼン環由来のプロトンおよびチオフェン環由 来のプロトンの積分比が目的構造と一致したことより確認した。測定データを以 下に示す。GPC測定値は、重量平均分子量(Mw)=1265、数平均分子量 (Mn) = 1241、分子量分布 (Mw/Mn) = 1.019であり、目的物が

20



高純度、単分散であることを確認した。

¹H NMR (CDCl₃) δ7.66 (d, J = 1.2Hz, ベンゼン環, 2H), δ7.65 (t, J = 1.2Hz, ベンゼン環, 1H), δ7.32 (d, J = 3.6Hz, チオフェン環, 1H), δ7.30 (d, J = 3.6Hz, チオフェン環, 2H), δ7.25-7.22 (m, ベンゼン環, 16H およびチオフェン環, 2H), δ7.18 (d, J = 3.6Hz, チオフェン環, 1H), δ7.13-7.10 (m, ベンゼン環, 16H およびチオフェン環, 2H), 7.08 (d, J = 3.6Hz, チオフェン環, 2H), 7.05 (dd, J = 5.2Hz, J = 3.6Hz, チオフェン環, 1H), 7.02-6.9 (m, ベンゼン環, 8H およびチオフェン環, 2H), 6.92 (d, J = 2.0Hz, ベンゼン環, 4H), 6.74 (t, J = 2.0Hz, ベンゼン環, 2H).

10 〈有機ホウ素化合物の連続的/断続的添加法、および塩基触媒の断続的添加法 によるSuzukiカップリング反応〉

合成実施例1-1で得られた5-(3,5-i)プロモフェニル)-2,2'-iチオフェン0.40g、パラジウム酢酸13mg、トリフェニルホスフィン46mg がよび炭酸ナトリウム0.11gに、窒素雰囲気下、THF4m1と水1m1を加え、80での油浴で加熱した。ここに合成実施例1-3で得られた5-(5'-i)につい酸-[2,2']ビチオフェニル-5-iル)-N,N,N',N'ーテトラフェニル-1,3-フェニレンジアミン<math>0.65gをテトラヒドロフラン3m1に溶解した溶液を、1時間かけて滴下し、さらに還流下で 0.5時間反応させた。次いで水1m1に溶解した炭酸ナトリウム0.11gを加えた後、合成実施例1-3で得られた5-(5'-i)に溶解した炭酸ナトリウム0.11gを加えた後、合成実施例1-3で得られた5-(5'-i)に溶解した炭酸ナトリウン0.11gを加えた後、合成実施例1-3で得られた1-(5'-i)の、1-10のでは、1-11のである。

反応終了後、室温まで冷却し、水20mlを添加した。得られた反応混合物を 25 塩化メチレンで抽出し、得られた有機層を水で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理し、溶媒を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck製 Silicagel 60, 溶離液:塩化メチレン/nーヘキサン)により単離精製し、目的物1.14g(淡黄色固体)を収率82%で得た。連続的および断続的添加法により収率が向上することを確認し

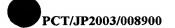
た。その構造は¹ H-NMRスペクトルが前記〈連続的又は断続的添加法を利用しないSuzukiカップリング反応〉と一致したこと、およびGPC測定値がほぼ同一であったことにより確認した。

(合成実施例1-5) 下記式で示される第2世代デンドリマーの合成

(構造式中のaは、¹H NMRスペクトルで積分値の基準としたプロトンHaの置換位置を示す。)

〈第1世代デンドリマーのチオフェン環の α 水素を活性基B (OH) $_2$ に変換する反応により下記式 (12) で示される第1世代デンドリマーのボロン酸誘導体の合成〉

25



窒素雰囲気下、合成実施例1-4で得られた第1世代デンドリマー1.4gを 脱水テトラヒドロフランに溶解し、ドライアイスーメタノール浴中で冷却した。 冷却後、10wt%ーリチウムジイソプロピルアミド/n-ヘキサン懸濁液2. 1g(Aldrich社製)を滴下し、そのまま1時間反応させた。続いてトリメ トキシボラン0. 42gを滴下し、そのまま1時間反応させた。反応終了後、水 5 を添加し加水分解させた後、冷却浴をはずして室温へ温度を上げた。反応混合物 に飽和塩化アンモニウム水溶液及びジエチルエーテルを添加し、撹拌、静置して から有機層を分離した。さらに水層をテトラヒドロフラン/ジエチルエーテル(1/2容量比)混合溶媒で抽出し、先の有機層をあわせた。得られた有機層を飽 和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した。さらに硫酸ナトリウムで乾燥処理を行なっ 10 た後、溶媒を減圧留去して粗製物を得た。粗製物をテトラヒドロフラン/n-ヘ キサンで再結晶し、目的物である第1世代のボロン酸誘導体(以下、「G1-B (OH)。」と略す) 0.9g(淡黄色固体)を収率63%で得た。その構造は ¹ H-NMRスペクトル(測定溶媒:DMSO-d⁶)にて、8.3ppm付近にボロン 15 酸のOHプロトンが観測されたこと、およびベンゼン環由来のプロトンとチオフ ェン環由来のプロトンの積分比が目的構造と一致したことより確認した。

〈連続的又は断続的添加法を利用しないSuzukiカップリング反応〉

20

25



. 6-7. 8ppm付近に観測される、ベンゼン環由来のプロトンおよびチオフェン環由来のプロトンの積分比が目的構造と一致したことより確認した。GPC測定値は、重量平均分子量(Mw)=3514、数平均分子量(Mn)=3385、分子量分布(Mw/Mn)=1.038であり、目的物が高純度、単分散であることを確認した。

〈有機ホウ素化合物の連続/断続的添加法、および塩基触媒の断続的添加法によるSuzukiクロスカップリング反応〉

合成実施例1-1で得られた5-(3,5-ジブロモフェニル)-2,2'-ビチオフェン0.12g、パラジウム酢酸4mg、トリフェニルホスフィン14mgおよび炭酸ナトリウム33mgに、窒素雰囲気下、THF1.6m1と水0.3m1を加え、80℃の油浴で加熱した。G1-B(OH)20.45gをテトラヒドロフラン0.7m1に溶解した溶液を、1時間かけて滴下し、さらに還流下で0.5時間反応させた。次いで水0.3m1に溶解した炭酸ナトリウム33mgを加えた後、G1-B(OH)20.45gをテトラヒドロフラン0.7m1に溶解した溶液を、1時間かけて滴下し、さらに還流下で5.5時間反応させた。

反応終了後、室温まで冷却し、水3m1を添加した。得られた反応混合物を塩化メチレンで抽出し、得られた有機層を水で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理し、溶媒を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck製 Silicagel 60,溶離液:塩化メチレン/nーヘキサン)により単離精製し、目的物である第2世代デンドリマー0.64g(淡黄色固体)を収率71%で得た。連続的および断続的添加法により収率が向上することを確認した。その構造は「HーNMRスペクトルが、前記〈連続的又は断続的添加法を利用しないSuzukiカップリング反応〉と一致したこと、およびGPC測定値がほぼ同一であったことにより確認した。

(合成実施例1-6) 下記式で示される第3世代デンドリマーの合成

10



(構造式中のaは、¹H NMRスペクトルで積分値の基準としたプロトンHaの置換位置を示す。)

合成実施例1-5で得られた第2世代デンドリマーのチオフェン環の α 水素を活性基B(OH) $_2$ に変換する反応により第2世代デンドリマーのボロン酸誘導体を合成し、次いで合成実施例1-1で得られた5-(3,5-i)プロモフェニル)-2,2'ービチオフェンとSuzukiクロスカップリング反応を行い、第3世代デンドリマーを合成した。なお、実施例1-5の条件で、第1世代デンドリマーの代わりに第2世代デンドリマーを用いる以外は全て同じ条件で行なった。得られた物質の構造は 1 H-NMRスペクトル(測定溶媒: CDC $_3$)にて、6.7 p m付近に観測される窒素原子が2つ隣接したベンゼン環プロトンHaを基準(8 H β)とし、6.9-7.4 p m付近および7.6-7.8 p m付近に観測される、ベンゼン環由来のプロトンおよびチオフェン環由来のプロトンの積分比が目的構造と一致したことより確認した。GPC測定値は、重量平均分子量(Mw)=7890、数平均分子量(Mn)=7610、分子量分布(Mw/Mn)=1.037であり、目的物が高純度、単分散であることを確認した。

15 [合成実施例2] 下記式で表わされる第1世代3分岐デンドリマー(第1世代

10

15



デンドリマーのベンゼン核コアへの結合)。

(構造式中のaは、¹H NMRスペクトルで積分値の基準としたプロトンHaの置換位置を示す。)

〈連続的又は断続的添加法を利用しないSuzukiクロスカップリング反応〉

合成実施例(1-5)の〈第1世代デンドリマーのチオフェン環の α 水素を活性基B(OH)。に変換する反応〉により得られた式(12)で表わされる第1世代デンドリマーのボロン酸誘導体G1-B(OH)。1.03g、1,3,5ートリプロモベンゼン68mg、パラジウム酢酸15mg、トリフェニルホスフィン51mgおよび炭酸ナトリウム95mgに、窒素雰囲気下、THF6m1と水1m1を加え、還流下で8時間反応させた。反応終了後、室温まで冷却し、水3m1を添加した。得られた反応混合物をクロロホルムで抽出し、得られた有機層を水で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理し、溶媒を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck Silicagel 60, 溶離液:塩化メチレン/n-ヘキサン)により単離精製し、さらにクロロホルムで再結晶し、目的物である第1世代3分岐デンドリマー0.36g(淡黄色固体)を収率39%で得た。その構造は1+NMRスペク

トル(測定溶媒: CDCl₃)にて、6.7ppm付近に観測される窒素原子が20隣接したベンゼン環プロトンHaを基準 (6H分)とし、6.9-7.2ppm付近および7.4-7.5ppm付近に観測される、ベンゼン環由来のプロトンおよびチオフェン環由来のプロトンの積分比が目的構造と一致したことより確認した。測定データを以下に示す。GPC測定値は、重量平均分子量 (Mw) = 5017 3であり、目的物が高純度、単分散であることを確認した。

¹H NMR (CDCl₃) 7.48 (s, ベンゼン環, 3H), 7.46 (s, ベンゼン環, 6H), 7.4 3 (s, ベンゼン環, 3H), 7.22-7.18 (m, ベンゼン環およびチオフェン環, 57H), 7.10-7.08 (m, ベンゼン環およびチオフェン環, 60H), 6.99-6.94 (m, ベンゼン環およびチオフェン環, 33H), 6.90 (d, J = 0.8Hz, ベンゼン環, 12H), 6.87 (d, J = 3.2Hz, チオフェン環, 6H), 6.73 (t, J = 2.0Hz, ベンゼン環, 6H).

〈有機ホウ素化合物の連続/断続的添加法、および塩基触媒の断続的添加法によるSuzukiクロスカップリング反応〉

1, 3, 5ートリプロモベンゼン68mg、パラジウム酢酸15mg、トリフ 15 エニルホスフィン51mgおよび炭酸ナトリウム32mgに、窒素雰囲気下、T HF1.5m1と水0.4mlを加え、80℃の油浴で加熱した。ここに合成実 施例(1-5)の〈第1世代デンドリマーのチオフェン環のα水素を活性基B (OH)。に変換する反応〉により得られた式(12)で表わされる第1世代デン ドリマーのボロン酸誘導体G1-B (OH) 2 0.34gをテトラヒドロフラン 20 1.5m1に溶解した溶液を、1時間かけて滴下し、さらに還流下で0.5時間 反応させた。次いで水0.3m1に溶解した炭酸ナトリウム32mgを加えた後 、G1-B (OH) $_2$ 0. 34gをテトラヒドロフラン1. 5mlに溶解した溶 液を、1時間かけて滴下し、さらに還流下で0.5時間反応させた。次いで水0 . 3m1に溶解した炭酸ナトリウム32mgを加えた後、G1-B(OH) $_2$ O 25 . 34gをテトラヒドロフラン1. 5m1に溶解した溶液を、1時間かけて滴下 し、さらに還流下で4時間反応させた。反応終了後、室温まで冷却し、水3m1 を添加した。得られた反応混合物をクロロホルムで抽出し、得られた有機層を水 で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理し、溶媒を減圧留去することで



粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck製 Silic agel 60, 溶離液:塩化メチレン/n-ヘキサン)により単離精製し、さらにクロロホルムで再結晶し、目的物である第1世代3分岐デンドリマー0.48g(淡黄色固体)を収率52%で得た。連続的および断続的添加法により収率が向上することを確認した。その構造は、前記(連続的又は断続的添加法を利用しないSuzukiカップリング反応〉と 1 H NMRスペクトルが一致し、GPC分析値がほぼ同一であったことにより確認した。

(合成実施例3) 第1世代3分岐デンドリマーの合成

(合成実施例3-1) デンドリック構造の単量体単位の化合物 (c) となる、 10 下記式で示される3, 5-ビス[2-(5-ブロモチエニル)]-2-チエニルベンゼン、および1, 3, 5-トリス[2-(5-ブロモチエニル)]ベンゼンの合成

〈有機ホウ素化合物の連続的添加法を利用しないSuzukiクロスカップリング反 15 応〉

窒素雰囲気下、チオフェン14gの脱水テトラヒドロフラン100mlに溶解し、ドライアイスーメタノール浴中で冷却した。-70℃以下に冷却後、1.6 M-n-ブチルリチウム/ヘキサン溶液100mlを40分間で滴下した。さらに1時間反応させた後、トリメトキシボラン20gを10分間かけて滴下した後、冷却浴を外してゆっくりと室温まで昇温し、反応混合物Aを得た。ここに、1,3,5-トリブロモベンゼン13g、酢酸パラジウム0.8g、トリフェニルホスフィン2.9g、及び炭酸ナトリウム8.7gをあらかじめ脱気および窒素置換したメタノール130 ml及び水25mlを加え、さらに窒素置換した後、85℃の油浴中で4時間反応した。反応終了後、メタノール50ml及び水

100mlを添加し、室温まで冷却した。析出物をろ過し、塩化メチレン100ml及び水100mlを加えた。不溶成分をろ別除去した後、有機層を分離し、水次いで飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理後、溶媒を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck製Silicagel60,溶離液:塩化メチレン/nーへキサン)により精製し、さらに塩化メチレンーメタノールで再結晶することで、下記式(13)に示す中間体となる1,3,5ートリス(2ーチエニル)ベンゼン7.6g(白色粉末)を収率57%で得た。その構造は1H NMRスペクトルにて確認した。測定データを以下に示す。

10

15

20

25

5

 1 H NMR(CDCl $_{3}$) δ 7.81(s, ベンゼン環, 3H), δ 7.74(dd, J = 3.6, 0.8 Hz , チオフェン環, 3H), δ 7.65(dd, J = 5.2, 0.8 Hz, チオフェン環, 3H), δ 7 .21(dd, J = 5.2, 3.6 Hz, チオフェン環, 3H).

〈有機ホウ素化合物の連続的添加法によるSuzukiカップリング反応〉

窒素雰囲気下、チオフェン14gの脱水テトラヒドロフラン100mlに溶解し、ドライアイスーメタノール浴中で冷却した。一70℃以下に冷却後、1.6 Mーnープチルリチウム/ヘキサン溶液100mlを40分間で滴下した。さらに1時間反応させた後、トリメトキシボラン20gを10分間かけて滴下した後、冷却浴を外してゆっくりと室温まで昇温し、反応混合物Aを得た。次いで、1,3,5ートリプロモベンゼン13g、酢酸パラジウム0.8g、トリフェニルホスフィン2.9g、及び炭酸ナトリウム8.7gをあらかじめ脱気および窒素置換したメタノール130ml及び水25mlを加え、さらに窒素置換した後、85℃の油浴中で加熱撹拌し、先に調製した反応混合物Aを80分かけて滴下し、さらに3時間反応した。反応終了後、メタノール50ml及び水100mlを添加し、室温まで冷却した。析出物をろ過し、塩化メチレン100ml及び水1

10

15



00m1を加えた。不溶成分をろ別除去した後、有機層を分離し、水次いで飽和 塩化ナトリウム水溶液で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理後、溶媒 を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Me rck製Silicagel60,溶離液:塩化メチレン/n-ヘキサン)によ り精製し、さらに塩化メチレンーメタノールで再結晶することで、式(13)に 示す中間体となる1,3,5ートリス(2ーチエニル)ベンゼン12g(白色粉末 ・)を収率90%で得た。有機ホウ素化合物の連続的添加法により収率が向上する ことを確認した。その構造は¹ H NMRスペクトルが前記〈有機ホウ素化合物 の連続的添加法を利用しないSuzukiクロスカップリング反応〉と一致したことに より確認した。

〈中間体1,3,5ートリス(2ーチエニル)ベンゼンのブロモ化反応〉 得られた1,3,5-トリス(2-チエニル)ベンゼン2.0gをジメチルホル ムアミド10mlに溶解し、氷水浴中で冷却した。そこにNーブロモコハク酸イ ミド2.4gのジメチルホルムアミド(9m1)溶液を添加した後、氷水浴を外 して室温まで昇温した。反応終了後、水を添加した。得られた反応混合物をクロ ロホルムで抽出し、得られた有機層を水で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで 乾燥処理し、溶媒を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィ ー (充填剤:Merck製 Silicagel 60, 溶離液:クロロホルム /n-ヘキサン)によりそれぞれ単離精製し、目的の3,5-ビス[2-(5-ブロモチエニル)]-2-チエニルベンゼン1.05g(白色固体)及び1,3 20 , 5ートリス[2-(5ーブロモチエニル)]ベンゼン1.49g(白色固体)を 得た。その構造は¹H-NMRスペクトルにより確認した。測定データを以下に 示す。

3, 5-ビス[2-(5-ブロモチエニル)]-2-チエニルベンゼン

¹H NMR(CDCl₃) δ 7.64(d, J = 1.6Hz, ベンゼン環, 2H), δ 7.52(t, J = 1 25 .6 Hz, ベンゼン環, 1H), δ7.39 (dd, J = 1.2Hz, J = 3.6 Hz, チオフェン環, 1H), δ7.35 (dd, J = 1.2Hz, J = 5.2Hz, チオフェン環, 1H), δ7.15-7.12 (m, チオフェン環, 3H) δ7.08 (d, J = 4.0Hz, チオフェン環, 2H).

1, 3, 5-トリス[2-(5-ブロモチエニル) ベンゼン



 1 H NMR(CDCl $_{3}$) δ 7.53(s, ベンゼン環, 3H), δ 7.07(d, J = 4.0 Hz, チオフェン環, 3H), δ 7.00(d, J = 4.0 Hz, チオフェン環, 3H).

(合成実施例 3-2) 下記式で表わされる1, 3-ジクロロ-5-(2-チェ = ν) ベンゼンの合成

5

〈有機ホウ素化合物の連続的添加法を利用しないSuzukiクロスカップリング反応〉

窒素雰囲気下、チオフェン7.0 gを脱水テトラヒドロフラン55mlに溶解. し、ドライアイス-メタノール浴中で冷却した。-70℃以下に冷却後、1.6 M-n-ブチルリチウム/ヘキサン溶液50mlを1時間で滴下した。さらに1 10 時間反応させた後、トリメトキシボラン9.8 gを10分間かけて滴下した後、 冷却浴から外してゆっくりと室温まで昇温し、反応混合物Aを得た。次いで反応 混合物Aに、窒素下雰囲気下、1-ブロモー3,5-ジクロロベンゼン16.3 g、酢酸パラジウム O. 5 g、トリフェニルホスフィン 1. 7 g、及び炭酸ナト リウム6.9gをあらかじめ脱気および窒素置換したメタノール150m1及び 15 水30m1を加え、さらに窒素置換した後、85℃の油浴中で4時間反応した。 反応終了後、メタノール50m1及び水100m1を添加し室温まで冷却した。 析出物をろ別除去し、塩化メチレン100m1及び水100m1を加えた。不溶 成分をろ別除去した後、有機層を分離し、水、次いで飽和塩化ナトリウムで3回 洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理後、溶媒を減圧留去することで粗 20 製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck製Silicag e 1 6 0, 溶離液:塩化メチレン/n-ヘキサン)により精製することで、目的 物11.7g(白色粉末)を収率70%で得た。その構造は1H NMRスペク トルにて確認した。測定データを以下に示す。



(br. ベンゼン環 1H)、δ7.09 (dd. J = 5.2, 3.6 Hz, チオフェン環, 1H). 〈有機ホウ素化合物の連続的添加法によるSuzukiクロスカップリング反応〉 窒素下雰囲気下、1ーブロモー3、5ージクロロベンゼン16.3g、酢酸パ ラジウムO.5g、トリフェニルホスフィン1.7g、及び炭酸ナトリウム6. 9gをあらかじめ脱気および窒素置換したメタノール150m1及び水30m1 5 を加え、さらに窒素置換した後、85℃の油浴中で加熱撹拌した。そこに前記〈 有機ホウ素化合物の連続的添加法を利用しないSuzukiクロスカップリング反応〉 と同様に調製した反応混合物 A を 1 時間かけて滴下し、さらに 3 時間反応した。 反応終了後、メタノール50m1及び水100m1を添加し室温まで冷却した。 析出物をろ別除去し、塩化メチレン100ml及び水100mlを加えた。不溶 10 成分をろ別除去した後、有機層を分離し、水、次いで飽和塩化ナトリウムで3回 洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理後、溶媒を減圧留去することで粗 製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck製Silicag e 1 6 0, 溶離液:塩化メチレン/nーヘキサン)により精製することで、目的 物15g(白色粉末)を収率90%で得た。前記〈有機ホウ素化合物の連続的添 15 加法を利用しないSuzukiクロスカップリング反応〉に比べ収率が向上することを 確認した。その構造は¹ H NMRスペクトルが前記〈有機ホウ素化合物の連続 的添加法を利用しないSuzukiクロスカップリング反応〉と一致したことにより確 認した。

(合成実施例 3-3) デンドリック構造の末端部分を構成する化合物 (a) となる、下記式で示される5-(2- チェニル)-N, N', N' ーテトラフェニル-1, 3- フェニレンジアミンの合成

20

窒素下雰囲気下、酢酸パラジウム0.01gのキシレン50m1溶液に、トリ

10

25



ー・ブチルホスフィン35mgを添加し、80℃の油浴中で10分間加熱撹拌、室温まで冷却することで触媒を調製した。続いて、窒素雰囲気下、合成実施例3-2で合成した1、3-ジクロロー5- (2-チエニル) ベンゼン10g、ジフェニルアミン16g及びカリウムーtーブトキシド12gをキシレン18mlに加え、80℃の油浴中で加熱した後、先に調製した触媒を添加し、その後120℃の油浴で18時間反応した。反応終了後、室温まで冷却し、有機層を水で洗浄、水層は塩化メチレンで2回抽出し、有機層を合わせ、さらに水で洗浄した。得られた有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理後、溶媒を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck製Silicage160、溶離液:塩化メチレン/n-ヘキサン)により精製し、さらに塩化メチレンーメタノールで再結晶することで目的物15g(白色粉末)を収率70%で得た。その構造は 1 H NMRスペクトルにて確認した。測定データを以下に示す。

¹H NMR (CDCl₃) δ7.22 (t, ベンゼン環, J = 7.6 Hz, 8H), δ7.16 (dd, J = 1.0, 5.2 Hz, チオフェン環, 1H), δ7.09 (d, J = 7.6 Hz, ベンゼン環, 8H), δ7.06 (dd, J = 1.0, 3.6 Hz, チオフェン環 1H), δ7.00-6.94 (m, ベンゼン 環及びチオフェン環, 5H), δ6.91 (d, J = 2.0Hz, ベンゼン環, 2H), δ6.73 (t , J = 2.0Hz, ベンゼン環, 1H).

¹H NMR (DMSO) δ7.43 (dd, J = 1.2, 5.2 Hz, チオフェン環, 1H), δ7.29 (t 20 , J = 8.0 Hz, ベンゼン環, 8H), δ7.43 (dd, J = 1.2, 3.6 Hz, ベンゼン環, 1 H), δ7.07-7.00 (m, ベンゼン環及びチオフェン環, 13H), δ6.73 (d, J = 2.0Hz , ベンゼン環, 2H), δ6.53 (t, J = 2.0Hz, ベンゼン環, 1H).

(合成実施例 3-4) デンドリック構造の末端部分を構成する化合物 (a) の チオフェン環の α 水素を活性基B (OH) $_2$ に変換して化合物 (b) とする、下 記式で示される 5-(5-ボロン酸-チオフェン-2-イル)-N, N', N'-テトラフェニル-1, <math>3-フェニレンジアミンの合成

10

15

20

窒素雰囲気下、ジイソプロピルアミン3.2gを脱水テトラヒドロフラン50 m1に溶解し、ドライアイスメタノール浴中で冷却した後、-70℃以下で、1 . 6M-n-ブチルリチウム/ヘキサン溶液19mlを10分間で滴下し、0℃ で30分反応させ、リチウムジイソプロピルアミド(LDA)溶液を調製した。続い て、合成実施例3-3で合成した5-(2-チエニル)-N, N, N', N'-テトラフェニルー1, 3ーフェニレンジアミン5.0gを脱水テトラヒドロフラ ン30m1に溶解し、ドライアイス-メタノール浴中で冷却した。この溶液に、 さきに調製したLDA溶液を1時間で滴下した。さらに-70℃以下で1時間反応し た後、トリメトキシボラン6.9gを10分間かけて滴下し、その後1時間かけ てゆっくりと室温まで昇温した。反応終了後、氷水浴中で冷却した後、ジエヂル エーテル70m1及び水20m1を添加し加水分解させた後、室温まで昇温した 。続いて、水50m1および飽和塩化アンモニウム水溶液70m1を添加し、有 機層を分離した。有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液120m1で2回、飽和 塩化ナトリウム水溶液120m1で2回洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥処理し、 溶媒を減圧留去することで、目的物 5.4g (微黄色粉末)を収率 99%で得た 。その構造は¹ H NMRスペクトルにて確認した。測定データを以下に示す。 ¹H NMR (DMSO) δ 8.20 (s, ボロン酸, 2H), δ 7.52 (d, J = 3.6Hz, チオフェ ン環, 1H), δ7.29 (t, J = 3.6Hz, ベンゼン環, 9H), δ7.16 (d, J = 3.6Hz, チオフェン環、1H)、 δ 7.07-7.02 (m, ベンゼン環、12H) 、 δ 6.75 (d, J = 2.0 Hz, ベンゼン環, 1H), δ6.54 (t, J = 2.0Hz, ベンゼン環 1H).

(合成実施例3-5) 下記式で表わされる第1世代デンドロンの合成

10

15

20

〈有機ホウ素化合物の連続/断続的添加法、および塩基触媒の断続的添加法を利用しないSuzukiクロスカップリング反応〉

合成実施例3-1で得られた3,5ービス[2-(5-ブロモチエニル)]-2
ーチエニルベンゼン1.49g、合成実施例3-4で得られた5-(5ーボロン酸ーチオフェンー2ーイル)ーN,N,N',N'ーテトラフェニルー1,3ーフェニレンジアミン3.98g、パラジウム酢酸69mg、トリフェニルホスフィン0.24gおよび炭酸ナトリウム0.85gに、窒素雰囲気下、THF30mlと水6mlを加え、還流下で8時間反応させた。反応終了後、室温まで冷却し、水20mlを添加した。得られた反応混合物を塩化メチレンで抽出し、得られた有機層を水で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理し、溶媒を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck製 Silicagel60,溶離液:塩化メチレン/nーへキサン)により単離精製し、目的物2.43g(白色固体)を収率60%で得た。その構造は1H-NMRスペクトルにより確認した。測定データを以下に示す。

¹H NMR (CDCl₃) δ7.68 (d, J = 1.6Hz, ベンゼン環, 2H), δ7.65 (t, J = 1.6Hz, ベンゼン環, 1H), δ7.40 (dd, J = 1.0Hz, J = 3.4Hz, チオフェン環, 1H), δ7.34 (dd, J = 1.0Hz, J = 5.2Hz, チオフェン環, 1H), δ7.29 (d, J = 3.6Hz, チオフェン環, 2H), δ7.26-7.22 (m, ベンゼン環, 16H および チオフェン環, 2H), δ7.13-7.08 (m, ベンゼン環, 16H および チオフェン環, 4H), 7.02-6.98 (m, ベンゼン環, 8H および チオフェン環, 1H), 6.91 (d, J = 2.0Hz, ベンゼン環, 4H), 6.74 (t, J = 2.0Hz, ベンゼン環, 2H).

〈有機ホウ素化合物の連続/断続的添加法、および塩基触媒の断続的添加法に

20



よるSuzukiクロスカップリング反応〉

合成実施例3-1で得られた3,5-ビス[2-(5-ブロモチエニル)]-2
ーチエニルベンゼン1.49g、パラジウム酢酸69mg、トリフェニルホスフィン0.24gおよび炭酸ナトリウム0.43gに、窒素雰囲気下、THF10
mlと水3mlを加え、80℃の油浴で加熱した。ここへ合成実施例3-4で得られた5-(5-ボロン酸ーチオフェン-2-イル)-N,N,N',N'ーテトラフェニルー1,3-フェニレンジアミン1.99gをテトラヒドロフラン10mlに溶解した溶液を、1時間かけて滴下し、還流下で0.5時間反応させた。次いで水3mlに溶解した炭酸ナトリウム0.42gを加えた後、合成実施例3-4で得られた5-(5-ボロン酸ーチオフェン-2-イル)-N,N',N'ーテトラフェニルー1,3-フェニレンジアミン1.99gをテトラヒドロフラン10mlに溶解した溶液を、1時間かけて滴下し、還流下で5.5時間反応させた。

反応終了後、室温まで冷却し、水20m1を添加した。得られた反応混合物を塩化メチレンで抽出し、得られた有機層を水で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理し、溶媒を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤: Merck製 Silicagel 60, 溶離液:塩化メチレン/nーヘキサン)により単離精製し、目的物3.40g(白色固体)を収率84%で得た。有機ホウ素化合物の連続/断続的添加法、および塩基触媒の断続的添加法により収率が向上することを確認した。その構造は「HーNMRスペクトルが合成実施例3-5と一致したことで確認した。

(合成実施例3-6) 合成実施例2と同じ構造の第1世代3分岐デンドリマ ーの合成

(第1世代デンドリマーのチオフェン環のα水素を活性基B(OH)。に変換 25 する反応により下記式(14)で示される第1世代デンドリマーのボロン酸誘導 体の合成〉

10

15

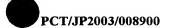
20



窒素雰囲気下、ジイツプロピルアミンO. 73gを脱水テトラヒドロフラン1 0m1に溶解し、ドライアイスメタノール浴中で冷却した後、-70℃以下で、 1. 6M-n-ブチルリチウム/ヘキサン溶液4. 3mlを10分間で滴下し、 O℃で15分反応させ、リチウムジイソプロピルアミド(LDA)溶液を調製し た。続いて、合成実施例3-5で得られた第1世代デンドリマー2.0gを脱水 テトラヒドロフラン30m1に溶解し、ドライアイスーメタノール浴中で冷却し た。この溶液に、さきに調製したLDA溶液を20分間で滴下した。さらに-70 ℃以下で1時間反応した後、トリメトキシボラン1.6gを10分間かけて滴下 し、その後1時間かけてゆっくりと室温まで昇温した。反応終了後、氷水浴中で 冷却した後、ジエチルエーテル20m1及び水20m1を添加し加水分解させた 後、室温まで昇温した。続いて、飽和塩化アンモニウム水溶液20m1を添加し 、有機層を分離した。有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液50m1で3回、飽 和塩化ナトリウム水溶液50m1で2回洗浄した。さらに硫酸ナトリウムで乾燥 処理を行なった後、溶媒を減圧留去して粗製物を得た。粗製物をテトラヒドロフ ラン/n-ヘキサンで再結晶し、目的物である第1世代のボロン酸誘導体2.0 g(淡黄色固体)を収率97%で得た。その構造は¹H-NMRスペクトル(測 定溶媒:DMSO-d⁶)にて、8.3ppm付近にボロン酸のOHプロトンが観測され たこと、およびベンゼン環由来のプロトンとチオフェン環由来のプロトンの積分 比が目的構造と一致したことより確認した。

〈有機ホウ素化合物の連続/断続的添加法、および塩基触媒の断続的添加法を 利用しないSuzukiクロスカップリング反応〉

25



上記式(14)で表される第1世代デンドリマーのボロン酸誘導体2.1g、 合成実施例3-1で得られた1,3,5-トリス[2-(5-ブロモチエニル)] ベンゼン238mg、パラジウム酢酸14mg、トリフェニルホスフィン50m gおよび炭酸ナトリウムO. 18gに、窒素雰囲気下、THF28mlと水2m 1を加え、還流下で8時間反応させた。反応終了後、室温まで冷却し、水20m 5 1を添加した。得られた反応混合物をクロロホルムで抽出し、得られた有機層を 水で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理し、溶媒を減圧留去すること で粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck製 Sili cagel 60, 溶離液:塩化メチレン/n-ヘキサン)により単離精製し、 さらにクロロホルムで再結晶し、目的物である第1世代3分岐デンドリマー0. 10 74g (淡黄色固体) を収率41%で得た。 1 H NMRスペクトルが合成実施 例2と一致することを確認した。GPC測定値は、重量平均分子量(Mw)=5 240、数平均分子量(Mn)=4855、分子量分布(Mw/Mn)=1.0 79であり、目的物が高純度、単分散であることを確認した。

15 〈有機ホウ素化合物の連続/断続的添加法、および塩基触媒の断続的添加法によるSuzukiクロスカップリング反応〉

合成実施例3-1で得られた1,3,5-トリス[2-(5-ブロモチエニル)]ベンゼン238mg、パラジウム酢酸14mg、トリフェニルホスフィン50mgおよび炭酸ナトリウム0.06gに、窒素雰囲気下、THF2m1と水0.4mlを加え、80℃の油浴で加熱した。ここに式(14)で表される第1世代デンドリマーのボロン酸誘導体0.7gをテトラヒドロフラン8.4mlに溶解した溶液を、1時間で滴下し、還流下で0.5時間反応させた。次いで水0.4mlに溶解した炭酸ナトリウム0.06gを加え、式(14)で表される第1世代デンドリマーのボロン酸誘導体0.7gをテトラヒドロフラン8.4mlに溶解した溶液を、1時間で滴下し、還流下で0.5時間反応させた。次いで水0.4mlに溶解した炭酸ナトリウム0.06gを加え、式(14)で表される第1世代デンドリマーのボロン酸誘導体0.7gをテトラヒドロフラン8.4mlに溶解した溶液を、1時間で滴下し、還流下で0.5時間反応させた。次いで水0.4mlに溶解した炭酸ナトリウム0.06gを加え、式(14)で表される第1世代デンドリマーのボロン酸誘導体0.7gをテトラヒドロフラン8.4mlに溶解した溶液を、1時間で滴下し、還流下で4時間反応させた。反応終了後、室温まで冷却し、水20mlを添加した。得られた反応混合物をクロロホルムで

10

15



抽出し、得られた有機層を水で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥処理し、溶媒を減圧留去することで粗製物を得た。カラムクロマトグラフィー(充填剤:Merck製 Silicagel 60,溶離液:塩化メチレン/nーへキサン)により単離精製し、さらにクロロホルムで再結晶し、目的物である第1世代3分岐デンドリマー1.01g(淡黄色固体)を収率56%で得た。有機ホウ素化合物の連続/断続添加、および塩基触媒の断続添加により、収率が向上することを確認した。その構造は¹ H NMRスペクトルが前記〈有機ホウ素化合物の連続/断続的添加法、および塩基触媒の断続的添加法を利用しないSuzukiクロスカップリング反応〉と一致したこと、およびGPC測定値がほぼ同一であることにより確認した。

産業上の利用可能性

本発明の製造方法によれば、過剰の原料を必要とせず合成中間体の精製も比較的容易である「Convergent法」を用いるため、欠陥がなく高純度のデンドリマーを効率的に合成することができ、化学分野、医薬分野、電子材料分野などにおいて、種々の高機能材料の創製に有用な高分子材料として期待される、チエニレン構造を有する新規なデンドリマーの提供が可能となる。



請求の範囲

チエニレン構造を含む線状部と置換基を有してもよい3価の有機基であ 1. る分岐部Yとからなる下記一般式(1)の繰り返し構造単位を有するデンドリマ 5 ーをConvergent法により製造するデンドリマーの製造方法であって、末端部分を 構成するチエニレン構造を有する下記化合物(a)のチオフェン環の α 位水素を suzukiクロスカップリング反応する活性基V、に変換して下記化合物(b)とす る反応工程1と、線状部及び分岐部Yを有すると共に分岐部Yに前記活性基V1 10 とsuzukiクロスカップリング反応する2つの活性基V。を有する下記化合物(c)と前記化合物(b)とをsuzukiクロスカップリング反応させて下記化合物(d)を得る反応工程 2 と、この生成物のチオフェン環の α 位水素をsuzukiクロスカ ップリング反応する活性基 V_1 に変換すると共にこれに下記化合物(c)を反応 させて次世代のデンドロンを得る反応工程3と、この反応工程3を必要に応じて 繰り返してデンドリマーとする工程とを具備することを特徴とするデンドリマー 15 の製造方法。

$$\begin{array}{c|c}
S & Z & Y \\
\hline
R_1 & R_2
\end{array}$$
(1)

$$\begin{array}{c|c} H & S & Z & Y_1 & W \\ \hline & R_1 & R_2 & (a) \end{array}$$



$$R_1$$
 R_2 V_2 V_2 V_2 V_2

(式中 Z は、置換基を有してもよい活性基を含まない 2 価の有機基又は単結合 であり、 R_1 、 R_2 は、水素、アルキル基及びアルコキシ基から選択される。また、Yは、置換基を有してもよい 3 価の有機基であり、 Y_1 は、Yと同一又はYと同一骨格を有する有機基である。Wは、置換基を有してもよい活性基を含まない 1 価の有機基であり、存在しなくてもよく、mは 0 又は 1 以上の整数である。活性基 V_1 及び V_2 は、互いにsuzuki 2 ロスカップリング反応する活性基から選 1 択される。)

2. 請求の範囲 1 において、前記活性基 V_1 が下記グループ 1 から選択され且つ前記活性基 V_2 が下記グループ 2 から選択されることを特徴とするデンドリマーの製造方法。



グループ1

$$-B(OH)_2$$
 $-B(OR)_2$
 $-B(OR)_2$
 $-CH_3$
 $-CH_3$
 $-CH_3$

R=メチル, エチル, イソプロピル, ブチル

グループ2

C1, Br, I, OSO₂ (
$$C_k F_{2k+1}$$
)
 $k=1\sim 4$

3. 請求の範囲1において、前記活性基 V_1 が下記グループ3から選択され 且つ前記活性基 V_2 が下記グループ4から選択されることを特徴とするデンドリ マーの製造方法。

グループ3

Cl, Br, I



グループ4

---B(OH)₂

---B(OR)2

R=メチル, エチル, イソプロピル, ブチル

- 4. 請求の範囲1~3の何れかにおいて、前記Suzukiクロスカップリング反応を行う際に用いる化合物のうちの一方がホウ素を含むチオフェン系有機ホウ素化合物の場合、このチオフェン系有機ホウ素化合物を、他方の化合物が含まれる反応系へ、徐々に連続的又は断続的に添加してSuzukiクロスカップリング反応させることを特徴とするデンドリマーの製造方法。
- 5. 請求の範囲 $1 \sim 4$ の何れかにおいて、前記反応工程 3 により又は前記反応工程 3 を繰り返すことにより得た下記一般式(e)の化合物のチオフェン環の α 位水素を前記活性基 V_1 に変換して下記化合物(f)とし、この化合物(f) とコアとなる Y_2 を有する下記化合物(g)とを反応させて下記一般式(g)で表される化合物とする反応工程を具備することを特徴とするデンドリマーの製造方法。



$$Y_2 - \left[V_2\right]_{\Gamma} \qquad (g)$$

(式中、Y₂はr価の有機基を表し、rは1以上の整数である。)

6. チエニレン構造を含む繰り返し構造単位を有するデンドリマーをConver



gent法により製造するデンドリマーの製造方法に用いられるビルディングブロックであり、下記一般式(I-1)で表わされることを特徴とする化合物。

$$V_3$$
 R_3
 R_4
 V_3
 V_3

(上記一般式(I-1)中、pは $1\sim10$ の整数を表わし、 R_3 、 R_4 は、水素 、 アルキル基、アルコキシ基から選択される。pが $2\sim10$ の場合、チェニレン の繰り返し単位ごとに R_3 、 R_4 が異なっていても良い。 V_3 は下記グループ 5 から選択される)。

グループ5

CI, Br, I,
$$OSO_2(C_kF_{2k+1})$$

k=1~4

 $-B(OH)_2$

 $-B(OR)_2$

R=メチル, エチル, イソプロピル, ブチル

7. 下記一般式(I-2)で表わされることを特徴とする化合物。



$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ R_7 & R_8 & S_2 \\ & & & \\ & & & \\ R_9 & R_{10} & S_3 \\ & & & \\ \end{array}$$

(上記一般式(I-2)中、 $S_1 \sim S_3$ は $1\sim 10$ の整数を表わし、それぞれ同一であっても異なっていてもよい。 $R_5 \sim R_1$ 。は、水素、アルキル基、アルコキシ基から選択され、チエニレンの繰り返し単位ごとに $R_5 \sim R_1$ 。が異なっていても良い。 V_4 は下記グループ 6 から選択される。)

グループ6

Cl, Br, I

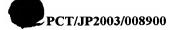
5

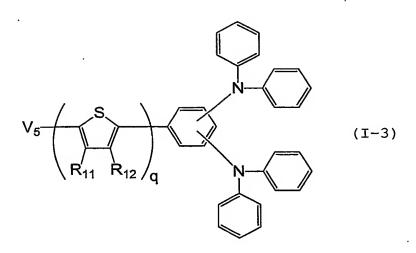
 $--B(OH)_2$

 $--B(OR)_2$

R=メチル, エチル, イソプロピル, ブチル

8. 下記一般式(I-3)で表わされることを特徴とする化合物。





(上記一般式(I-3)中、qは $1\sim10$ の整数を表わし、qが $2\sim10$ の場合、チエニレンの繰り返し単位ごとに R_{11} , R_{12} が異なっていても良い。 V_5 は下記グループ 7 から選択される。)

5

グループ7

H, Cl, Br, I

 $--B(OH)_2$

 $-B(OR)_2$

R=メチル, エチル, イソプロピル, ブチル

9. チオフェン系有機ホウ素化合物と反応性化合物とをSuzukiクロスカップ リング反応させてチオフェン系化合物を得るチオフェン系化合物の製造方法にお



いて、前記反応性化合物が含まれる反応系に、前記チオフェン系有機ホウ素化合物を、徐々に連続的又は断続的に添加してSuzukiクロスカップリング反応させることを特徴とするチオフェン系化合物の製造方法。

10. 請求の範囲9において、前記チオフェン系有機ホウ素化合物が下記グ 5 ループ1から選択される活性基V。を有し、且つ前記反応性化合物が下記グルー プ2から選択される活性基V。を有することを特徴とするチオフェン系化合物の 製造方法。

グループ 1
$$-B(OH)_2$$

$$-B(OR)_2$$

$$-B(OR)_2$$
CH₃

$$-CH_3$$
CH₃

R=メチル, エチル, イソプロピル, ブチル

グループ2

C1, Br, I, OSO₂ ($C_k F_{2k+1}$) $k=1\sim 4$



International application No.
PCT/JP03/08900

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER						
Int.	Cl ⁷ C08G61/12, C07D333/18, C07D	ს333/20				
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both nati	ional classification and IPC				
	S SEARCHED					
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed b	y classification symbols)				
Int.	Cl ⁷ C08G61/12, C07D333/18, C07I	D333/20				
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched			
101	yte home committed discrete	of data been and only	roh tarma used			
Electronic da WPI (ata base consulted during the international search (name	ou uata vase and, where practicable, sear	ion terms used)			
weT(
C. DOCID	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
·		remainte of the second	Dalamark			
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.			
х	US 6025462 A (EIC Laboratorie		1-7,9-10			
	15 February, 2000 (15.02.00), Claims; column 8; Figs. 1 to					
	(Family: none)	-				
	-					
A	JP 2002-20740 A (Mitsubishi (Chemical Corp.),	1-10			
	23 January, 2002 (23.01.02), Claims; Par. Nos. [0016] to [00181: Fige 1 +0 4				
1 I	Claims; Par. Nos. [UU16] to [(Family: none)	,				
	_					
A	JP 2001-247861 A (Sumitomo Cl		1-10			
1	14 September, 2001 (14.09.01) Claims; Par. No. [0055]	•				
	Claims; Par. No. [0055] (Family: none)					
			•			
ļ i						
! . !						
Fueth	ler documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	<u>.</u>			
<u></u>			emational filing data			
"A" docum	al categories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte priority date and not in conflict with t	the application but cited to			
conside	ered to be of particular relevance document but published on or after the international filing	understand the principle or theory und "X" document of particular relevance; the	derlying the invention			
date		considered novel or cannot be considered	ered to involve an inventive			
cited to	nent which may throw doubts on priority claim(s) or which is o establish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be			
special	special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is					
means	means combination being obvious to a person skilled in the art					
than th	nent published prior to the international filing date but later the priority date claimed					
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sear				
22 \$	September, 2003 (22.09.03)	21 October, 2003 (2	_1.10.03)			
						
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
J	THE PROPERTY OFFICE					
Facsimile No.		Telephone No.				



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/08900

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' C08G61/12, C07D333/18, C07D333/20

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' C08G61/12, C07D333/18, C07D333/20

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

WPI(L)

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
X	US 6025462 A (EIC Laboratories Inc.) 2000.02.15、特許請求の範囲、第8欄、図1-2 (ファミリーなし)	1-7、9- 10			
A	JP 2002-20740 A (三菱化学株式会社) 2002.01.23、特許請求の範囲、【0016】-【001 8、】図1-4 (ファミリーなし)	1-10			
A	JP 2001-247861 A (住友化学工業株式会社)	1-10			

| C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 21.10.03 22.09.03 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 8215 4 J 日本国特許庁(ISA/JP) 佐藤 邦彦 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 6825





国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/08900

				
C (続き). 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは	関連する 請求の範囲の番号		
A7-19-+	2001.09.14、特許請求の範囲、 (ファミリーなし)		1550(マン中国社)マン田 ジ	
	·			
	·			
	,			
	,			